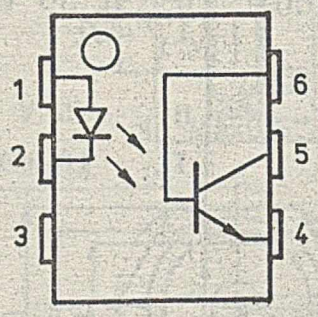
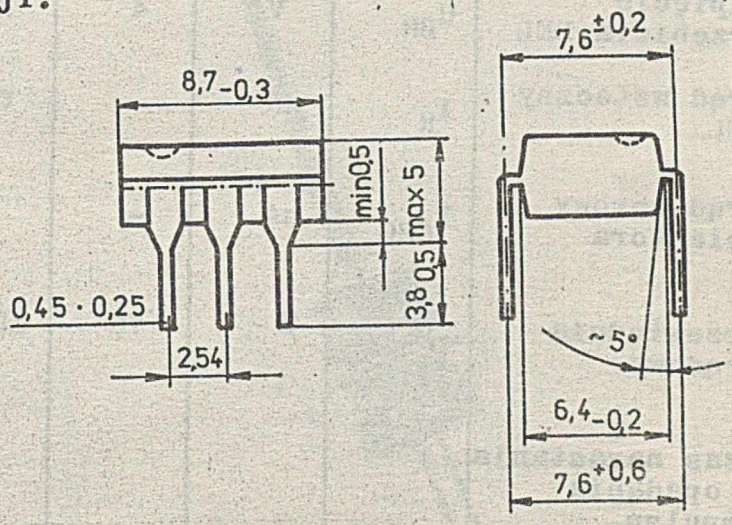
TRANSOPTOR CQ33BP

CQ33BP jest nowoczesnym transoptorem o dużej przekładni prądowej i wysokim napięciu izolacji. Składa się z diody elektroluminescencyjnej z GaAs, sprzężonej optycznie z krzemowym fototranzystorem typu n-p-n. Jest wykonany w 6-wyprowadzeniowej obudowie typu DIL z tworzywa sztucznego. Znajduje zastosowanie w systemach automatyki sterowania i innych układach wymagających galwanicznej separacji.



Rys. 1. Układ wyprowadzeń transoptora CQ33BP



Rys. 2. Obudowa transoptora CQ33BP

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE /t_{amb} = 25°C/

Prąd wejściowy	I_F = 60 mA
Napięcie wsteczne na wejściu	U_R = 3 V
Moc strat DEL	P_{tot1} = 100 mW
Napięcie kolektor-emiter	U_{CEO} = 32 V
Napięcie kolektor-baza	U_{CBO} = 50 V
Napięcie emiter-baza	U_{EBO} = 7 V
Moc strat detektora	P_{tot2} = 100 mW
Całkowita moc strat w transoptorze	P_{tot} = 150 mW

Napięcie wejście-wyjście	U_{IO} = 2,5 kV
Zakres temperatury otoczenia w czasie pracy	-40...+55 °C
Zakres temperatury przechowywania	-40...+70 °C

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /t_{amb} = 25°C/

Nazwa parametru	Symbol	Jedn.	Wartość			Warunki pomiaru
			min.	typ.	max.	
Napięcie przewodzenia DEL	U_F	V	-	1,3	1,65	I_I = 60 mA
Napięcie przebicia DEL	U_{BR}	V	4	20	-	I_R = 100 µA
Prąd wsteczny DEL	I_R	µA	-	0,03	10	U_R = 3 V
Prąd zerowy kolektora	I_{CEO}	nA	-	5	100	U_{CE} = 30 V I_I = 0
Przekładnia prądowa	$\frac{I_O}{I_I}$	%	70	120	-	U_{CE} = 5 V I_C = 10 mA
Czas narastania i opadania impulsu wyjściowego	t_r, t_f	µs	-	3	5	I_I = 10 mA U_{CC} = 5 V R_L = 100Ω

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

Telex 815647
Tel. 435401

Druk ZOINTE ITE zam. / . n.